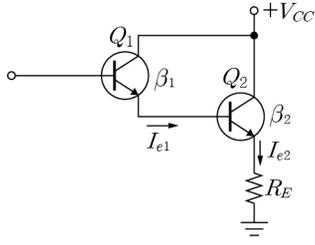
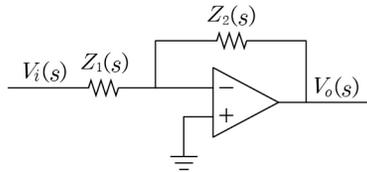


1. 다음 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



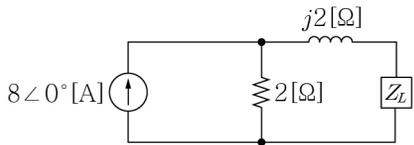
- ① 달링턴 쌍(Darlington Pair) 회로이다.
- ② 입력저항을 크게 하기 위한 목적으로 사용되며 입력저항은  $\beta_1\beta_2R_E$ 이다.
- ③ 전체 전류이득은  $\beta_1\beta_2$ 이다.
- ④ 트랜지스터  $Q_2$ 의 이미터 전류  $I_{e2} = \beta_1\beta_2I_{e1}$ 이다.

2. 다음 연산증폭기에서  $Z_1(s)$ 는 저항  $R_1$ 과 커패시터  $C_1$ 의 병렬회로,  $Z_2(s)$ 는 저항  $R_2$ 와 커패시터  $C_2$ 의 병렬회로이다.  $R_1 = 1[\text{k}\Omega]$ ,  $R_2 = 2[\text{k}\Omega]$ ,  $C_1 = 0.5[\text{mF}]$ ,  $C_2 = 0.1[\text{mF}]$  일 때  $V_o(s)/V_i(s)$ 는?



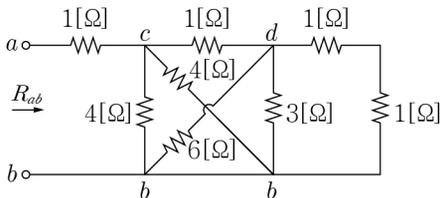
- ①  $-5 \frac{(s+2)}{(s+5)}$
- ②  $5 \frac{(s+2)}{(s+5)}$
- ③  $-5 \frac{(s+5)}{(s+2)}$
- ④  $5 \frac{(s+5)}{(s+2)}$

3. 다음 회로에서 부하  $Z_L$ 에 최대 평균전력이 전달되기 위한  $Z_L$  값과 이때의 소비전력은?



- ① 2 [Ω], 32 [W]
- ② j2 [Ω], 32 [W]
- ③ 2 - j2 [Ω], 16 [W]
- ④ 2 + j2 [Ω], 16 [W]

4. 다음 회로에서  $R_{ab}$ 는 얼마인가?



- ① 1 [Ω]
- ② 2 [Ω]
- ③ 3 [Ω]
- ④ 4 [Ω]

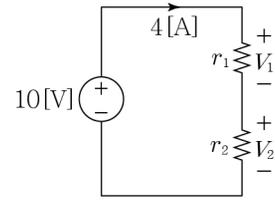
5. 다음의 값들 중에서 다른 하나는 무엇인가?

- ① 205<sub>10</sub>
- ② 11001011<sub>2</sub>
- ③ 313<sub>8</sub>
- ④ CB<sub>16</sub>

6. 회로 내 어떤 저항  $R$ 의 양단 전압이  $v(t) = V_M \cos(\omega t)$  [V] 일 때, 이 저항  $R$ 에서의 전류  $i(t)$  [A]와 순시전력  $P$  [W]에 대하여 옳지 않은 것은?

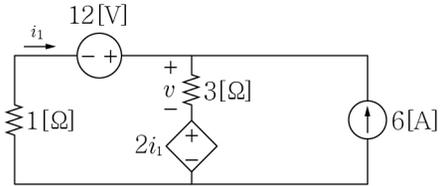
- ① 전류  $i(t)$ 의 각주파수는  $\omega$  [rad/s]이다.
- ② 전류  $i(t)$ 의 최댓값은  $\frac{V_M}{R}$  [A]이다.
- ③ 순시전력  $P$ 의 각주파수는  $2\omega$  [rad/s]이다.
- ④ 순시전력  $P$ 의 최댓값은  $\frac{V_M^2}{2R} + 1$  [W]이다.

7. 다음 회로에서  $V_1$  ( $r_1$ 의 양단 전압)이  $V_2$  ( $r_2$ 의 양단 전압)의 2배일 때, 저항  $r_1$ 과 저항  $r_2$ 의 값은?



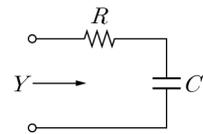
- ①  $r_1 = 1/3$  [Ω],  $r_2 = 2/3$  [Ω]
- ②  $r_1 = 2/3$  [Ω],  $r_2 = 1/3$  [Ω]
- ③  $r_1 = 10/6$  [Ω],  $r_2 = 5/6$  [Ω]
- ④  $r_1 = 5/6$  [Ω],  $r_2 = 10/6$  [Ω]

8. 다음 회로에서 3 [Ω] 저항이 소비하는 전력은?



- ① 25 [W]
- ② 50 [W]
- ③ 75 [W]
- ④ 100 [W]

9. 다음 회로의 등가 어드미턴스  $Y$ 는 각주파수  $\omega$ 가 1,000 [rad/s] 일 때  $1 + j2$ 이다.  $C$  값은 얼마인가?

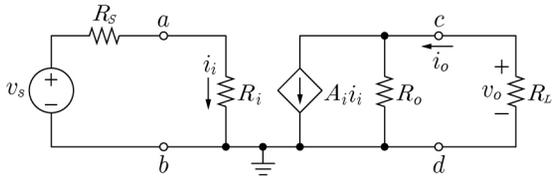


- ① 0.2 [mF]
- ② 1.5 [mF]
- ③ 2 [mF]
- ④ 2.5 [mF]

10. MOSFET가 JFET에 비해 가지고 있는 특징으로 옳지 않은 것은?

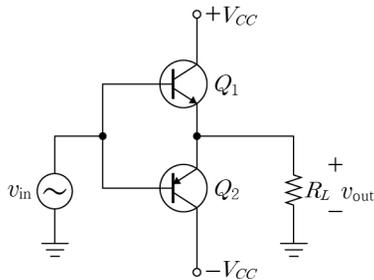
- ① 입력 저항이 크다.
- ② 캐리어의 이동도가 높다.
- ③ 소스 - 드레인 사이가 전기적으로 기판에서 독립되어 있다.
- ④ 한 장의 기판 위에서 얻을 수 있는 소자 수가 많아 집적 회로에 유리하다.

11. 다음은 BJT 증폭기에 대한 등가회로의 한 예이다. 소자 값들이  $R_s = 500 [\Omega]$ ,  $R_i = 1 [\text{k}\Omega]$ ,  $R_o = 40 [\text{k}\Omega]$ ,  $R_L = 10 [\text{k}\Omega]$ ,  $A_i = 100$ 으로 주어질 때 전류의 비  $i_o/i_i$ 는?



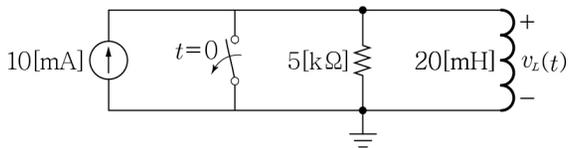
- ① 20      ② 50      ③ 80      ④ 100

12. 다음 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① B급 푸시풀 전력 증폭기이다.  
 ②  $v_{out}$ 에서는  $v_{in}$  입력과 위상이 반전된 출력이 나온다.  
 ③ 입력신호의 양의 반주기 동안  $Q_1$  트랜지스터가 도통된다.  
 ④ 교차왜곡이 없는 경우,  $Q_1$ 이 도통되면  $Q_2$ 는 차단된다.

13. 다음 회로에서  $t \geq 0$ 에서 시간에 관한  $v_L(t)$ 의 식은?  
 (단, 스위치는 충분히 오랫동안 닫혀 있었고  $t = 0$ 에서 열린다.)



- ①  $v_L(t) = 80e^{-4 \times 10^{-6}t} [\text{V}]$       ②  $v_L(t) = 80e^{-4 \times 10^6t} [\text{V}]$   
 ③  $v_L(t) = 50e^{-2.5 \times 10^{-5}t} [\text{V}]$       ④  $v_L(t) = 50e^{-2.5 \times 10^5t} [\text{V}]$

14.  $R = 6 [\Omega]$ ,  $X_L = 8 [\Omega]$ 인 직렬 RL 회로에서 100 [V], 60 [Hz]의 교류전압을 인가할 때 회로에 공급되는 유효전력은?

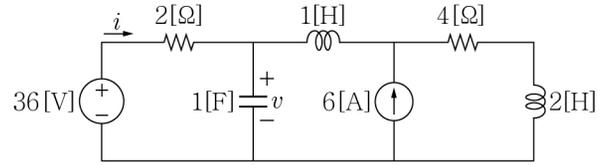
- ① 300 [W]      ② 400 [W]  
 ③ 600 [W]      ④ 800 [W]

15. 다음은 n형 반도체와 p형 반도체에 대한 설명이다. 옳은 것을 모두 고르면?

	반도체 종류	불순물 원소	다수 캐리어	소수 캐리어	이온의 전하
Ⓐ	n형 반도체	제5족 P, As, Sb	전자	홀	+q
Ⓑ	n형 반도체	제3족 B, Al, Ga	홀	전자	-q
Ⓒ	n형 반도체	제5족 B, Al, Ga	전자	홀	+q
Ⓓ	n형 반도체	제3족 P, As, Sb	홀	전자	-q
Ⓔ	p형 반도체	제5족 P, As, Sb	전자	홀	+q
Ⓕ	p형 반도체	제3족 B, Al, Ga	홀	전자	-q
Ⓖ	p형 반도체	제5족 B, Al, Ga	전자	홀	+q
Ⓗ	p형 반도체	제3족 P, As, Sb	홀	전자	-q

- ① a, f      ② b, e      ③ c, h      ④ d, g

16. 다음 회로가 직류정상상태에 있다고 할 때 커패시터의 전압  $v$ 는?

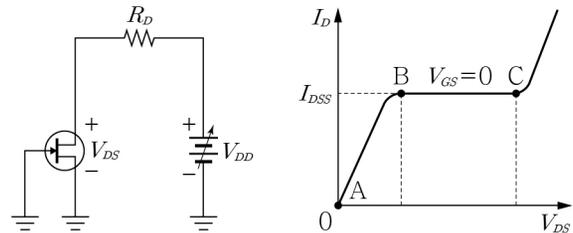


- ① 12 [V]      ② 16 [V]      ③ 24 [V]      ④ 32 [V]

17. 코일을 감은 횟수가 100 회이고, 0.2초 동안에 자속이 8 [Wb]에서 4 [Wb]로 감소했다면, 이 코일에 유도되는 유도기전력은?

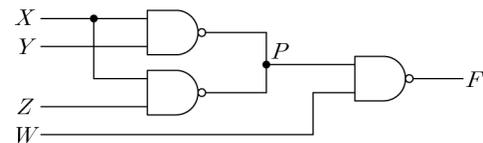
- ①  $2 \times 10^2 [\text{V}]$       ②  $2 \times 10^3 [\text{V}]$   
 ③  $4 \times 10^2 [\text{V}]$       ④  $4 \times 10^3 [\text{V}]$

18. 다음 회로의 동작을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?



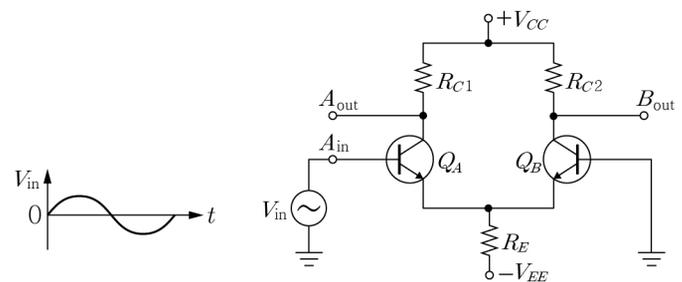
- ① A점에서  $V_{GS} = 0 [\text{V}]$ 일 때  $V_{DS} = 0$ 이면  $I_D = 0$ 이 된다.  
 ② B-C영역에서  $V_{DS}$ 와  $I_D$ 가 옴(Ohm)의 법칙을 따르므로 저항성 영역이라 한다.  
 ③  $V_{GS} = 0 [\text{V}]$ 일 때,  $I_D$ 가 일정하게 되는 B점을 핀치오프 전압(pinch-off voltage)이라 한다.  
 ④ C점 이후의 영역은 드레인과 게이트 사이의 역바이어스가 커져 항복현상(break down)이 일어난다.

19. 다음 논리 회로를 만족하는 출력 F의 논리식은?



- ①  $X(Y+Z) + \overline{W}$       ②  $\overline{X(Y+Z)} + W$   
 ③  $XYZ + \overline{W}$       ④  $\overline{XYZ} + W$

20.  $A_{in}$  단자에 아래의 입력  $V_{in}$ 이 주어졌을 때  $A_{out}$ 에서의 출력 파형은?



- ①  $V_{A_{out}}$  vs  $t$  (inverted sine wave)  
 ②  $V_{A_{out}}$  vs  $t$  (sine wave)  
 ③  $V_{A_{out}}$  vs  $t$  (inverted sine wave)  
 ④  $V_{A_{out}}$  vs  $t$  (sine wave)